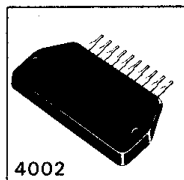


# STK-011

Thick Film Hybrid IC

## 6.5W min. AF Power Amplifier

6.5W min  
AFパワーアンプ



★IMST system.

⊖ C382B

最大定格 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

			unit
最大電源電圧	$V_{CC \text{ max}}$	ピン ③① 間	38 V
動作時 IC 基板温度	$T_C$		90 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$		-30 ~ +100 $^\circ\text{C}$
負荷短絡許容時間	$t_B$	$V_{CC} = 25\text{V}^{**}, P_O = 6.5\text{W}, R_L = 8\Omega, f = 50\text{Hz}$	2 sec

推奨動作条件 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

			unit
推奨電源電圧	$V_{CC}$		25 V
負荷抵抗	$R_L$		8 $\Omega$

動作特性 /  $T_a = 25^\circ\text{C}, V_{CC} = 25\text{V}, R_L = 8\Omega, R_g = 600\Omega, f = 1\text{kHz}, R_{NF} = 3\text{k}\Omega$ , 指定測定回路において

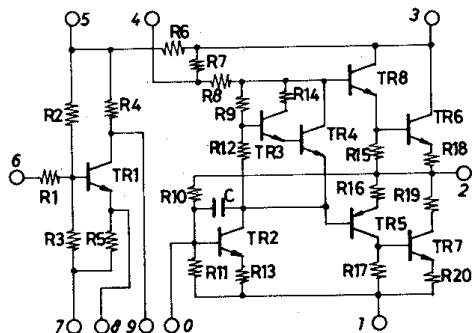
			min	typ	max	unit
無信号電流	$I_{CC0}$		10	20	50	mA
出力電力	$P_O$	THD = 2.0%	6.5			W
電圧利得	VG	$P_O = 0.1\text{W}$	34	35	36	dB
全高調波ひずみ率	THD	$P_O = 0.1\text{W}$			1.0	%
入力抵抗	$r_i$	$P_O = 0.1\text{W}$	15k	40k		$\Omega$
出力抵抗	$r_o$	$P_O = 0.1\text{W}$		0.2		$\Omega$
高域カットオフ周波数	$f_{CH}$	$v_i = 50\text{mV}, -3\text{dB}$	50k			Hz
低域カットオフ周波数	$f_{CL}$	$v_i = 50\text{mV}, -3\text{dB}$			30	Hz
出力帯域幅	PBW	THD = 2.0%, -3dB		30 ~ 30k		Hz
出力雑音電圧	$V_{NO}$	$V_{CC} = 25\text{V}^{**}, R_g = 10\text{k}\Omega$ シヤント			4.0	$\text{mV}^{***}$

[注] 検査時の電源には 指定のないかぎり定電圧電源を使用する。

※ 電源は 指定トランス電源を使用する。

※※ 平均値指示型実効値目盛のVTVMのピーク値を示す。

等価回路



外形図 4002  
(unit: mm)

